ANSWER 7 OF 10 HCAPLUS COPYRIGHT 2004 ACS on STN 997:526149 Document No. 127:206357 UV-curable fluorine-containing silicone compositions. Yamamoto, Michiharu (Nitto Denko Corp., Japan). Jpn. Kokai Tokkyo Koho Jp 09202855 A2 19970805 Heisei, 35 pp. (Japanese). CODEN: JKXXAF. APPLICATION: JP 1996-11149 19960125.

The highly sensitive compns., useful for photoresists, AB etc., comprise (A) perfluorobutadienyl arom. compds. [F2C:CFC(CF3):CCF3]mAr (Ar = m-valent arom. hydrocarbon having H at ≥ 1 o-positions; $m \geq 1$), (B) organopolysiloxanes having ≥2 Si-bonded alkenyl groups, (C) organohydropolysiloxanes having ≥ 3 Si-H, and (D) catalysts for addn. reaction of the alkenyl groups and Si-H. Thus, 1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5-trimethyltrisiloxane (I) 2.00, hexamethyltrisiloxane (II) 4.00, and divinylsiloxane 0.085 mmol were treated in the presence of H2SO4 to give a vinyl group-terminated siloxane (III), sep., I 2.00, II 2.00, tetramethyldisiloxane 0.234, and tetramethyltetrasiloxane 0.220 mmol were treated in the presence of H2SO4 to give an organohydropolysiloxane (IV). A UV-cured film formed from a m-bis(trifluoromethyl)benzene soln. contg. 100 parts a III-IV mixt. (Si-H/vinyl 2.0), chloroplatinic acid, and 100 parts (perfluorobutadienyl)benzene showed reduced min. UV energy for dissoln. in Et3N-contg. N-methyl-2-pyrrolidone.

IT 188819-66-1P 188819-81-0P

(highly photosensitive silicone compns. for photoresist contg.)

RN 188819-66-1 HCAPLUS

CN Benzene, 1-(2-propenyloxy)-4-[3,4,4-trifluoro-1,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-butadienyl]- (9CI) (CA INDEX NAME)

RN 188819-81-0 HCAPLUS

CN Naphthalene, 1-(2-propenyloxy)-5-[3,4,4-trifluoro-1,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-butadienyl]- (9CI) (CA INDEX NAME)

IC ICM C08L083-07

ICS C08K005-02; C08L083-05

CC 37-3 (Plastics Manufacture and Processing) Section cross-reference(s): 74

IT Polysiloxanes, preparation

(alkenyl; highly photosensitive silicone compns. for photoresists)

IT Photoresists

(highly photosensitive silicone compns.)

IT Polysiloxanes, preparation

(hydrogen; highly photosensitive silicone compns. for

photoresists)

IT 66268-57-3DP, vinyl group-terminated 188819-66-1P

188819-81-0P 194551-29-6P 194551-30-9P 194551-31-0P

194551-32-1DP, hydrosilyl-terminated

(highly photosensitive silicone compns. for **photoresist** contq.)

IT 188819-71-8DP, derivs. 188819-74-1DP, derivs.

(highly photosensitive silicone compns. for **photoresists**

L30 ANSWER 8 OF 10 HCAPLUS COPYRIGHT 2004 ACS on STN

1993:639606 Document No. 119:239606 Manufacture of semiconductor having fluoropolymer protecting layer. Unoki, Masao; Yokozuka, Toshisuke; Nakamura, Hide (Asahi Glass Co Ltd, Japan). Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 05198502 A2 19930806 Heisei, 9 pp. (Japanese). CODEN: JKXXAF. APPLICATION: JP 1992-168416 19920603. PRIORITY: JP 1991-162171 19910606.

AB The semiconductor is manufd. by (1) applying a **photoresist** soln. contg. a surfactant on a fluoropolymer or applying a surfactant-contg. soln. on a fluoropolymer and then a **photoresist** soln., (2) exposing, (3) developing, and (4) etching to work the fluoropolymer finely. The 1,1,2,4,4,5,5-heptafluoro-3-oxa-1,6-heptadiene homopolymer protecting film showed low surface energy and low water absorption.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-202855

(43)公開日 平成9年(1997)8月5日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C08L 83/07	LRP		C 0 8 L 83/07	LRP
C08K 5/02			C 0 8 K 5/02	
C 0 8 L 83/05			C 0 8 L 83/05	

		審査請求	未請求 請求項の数12 OL (全 35 頁)		
(21)出廣番号	特願平811149	(71)出願人	000003964 日東電工株式会社		
(22)出廣日	平成8年(1996)1月25日	:	大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号		
		(72)発明者	山本 道治		
			大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内		
		(74)代理人	弁理士 牧野 逸郎		

(54) 【発明の名称】 紫外線感光性含フッ素シリコーン組成物

(57)【要約】

【課題】紫外線に対して高感度を有する紫外線感光性含 フッ素シリコーン組成物を提供することにある。

【解決手段】本発明による紫外線感光性含フッ素シリコーン組成物は、(a) 一般式(I)

【化1】

$$\left(\begin{array}{c} F_2C - CF \\ CF_3 \end{array}\right) = CF_3 A \Gamma$$

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合している炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子に水素原子が結合しているm価の芳香族炭化水素基を示し、mは1以上の整数を示す。)で表わされるパーフルオロブタジエニル芳香族化合物、(b)分子中にケイ素に結合したアルケニル基を少なくとも2個有するアルケニル型オルガノポリシロキサン、(c)分子中にケイ素に結合した水素原子を少なくとも3個有するオルガノヒドロポリシロキサン、及び(d)ケイ素原子に結合したアルケニル基の水素原子を有するケイ素原子への付加反応に対

する触媒を含むことを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】(a) 一般式(I)

【化1】

$$\begin{pmatrix}
F_2C = CF \\
CF_3
\end{pmatrix} = CF_3$$
(1)

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合し ている炭素原子の少なくとも 1 つのオルト位の炭素原子 10 が一般式 (II) に水素原子が結合しているm価の芳香族炭化水素基を示 し、mは1以上の整数を示す。)で表わされるパーフル*

(d) ケイ素原子に結合したアルケニル基の水素原子を有

(b) 分子中にケイ素に結合したアルケニル基を少なくと

も2個有するアルケニル型オルガノポリシロキサン、 (c) 分子中にケイ素に結合した水素原子を少なくとも3

個有するオルガノヒドロポリシロキサン、及び

*オロブタジエニル芳香族化合物、

【請求項2】アルケニル型オルガノポリシロキサン(b)

【化2】

(式中、R1 はアルケニル基を示し、Rは相互に同一で ルオロアルキル基か、(ポリ)オキシフルオロアルキレ ンオキシアルキレン基か、又はアルキル基を置換基とし て有していてもよいフェニル基を示し、xは1又は2の 整数を示し、p及びqはそれぞれp≧0及びq≧0を満 たす整数を示す。)で表わされる請求項1に記載の紫外 線感光性含フッ素シリコーン組成物。

【請求項3】オルガノヒドロポリシロキサン(c) が一般 式(III)

※(式中、Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数 も異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、フ 20 1~8のアルキル基か、又はアルキル基を置換基として 有していてもよいフェニル基を示し、h及びiはそれぞ れh≥1及びi≥0を満たす整数を示し、Tは水素原子 又は上記Rを示し、Tが上記Rであるとき、hはh≥3 を満たす整数を示す。)で表わされる請求項1に記載の 紫外線感光性含フッ素シリコーン組成物。

【請求項4】アルケニル型オルガノポリシロキサン(b) が一般式(IV)

【化4】

RI R $(CH_z)_{k} = 0 - Ar$ $(R^{1})_{3-x}R_{x}Si0-[-Si0-]_{p}-[-Si0-]_{q}-[-Si0-]_{r}-SiR_{x}(R^{1})_{3-x}$ R R R (IV)

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合し ている炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子 に水素原子が結合している2価の芳香族炭化水素基を示 す。R1 はアルケニル基を示し、Rは相互に同一でも異 なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又はア ルキル基を置換基として有していてもよいフェニル基を 示し、kは3~6の整数を示し、xは1又は2の整数を★50 式 (V)

★示し、p、q及びrはそれぞれp≥0、q≥0及びr≥ 1を満たす整数を示す。)で表わされるパーフルオロブ タジエニル基含有アルケニル型オルガノポリシロキサン である請求項1に記載の紫外線感光性含フッ素シリコー ン組成物。

【請求項5】オルガノヒドロポリシロキサン(c) が一般

【化5】

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合し 10*【化6】 ている炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子 に水素原子が結合している2価の芳香族炭化水素基を示 す。Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~ 8のアルキル基か、又はアルキル基を置換基として有し ていてもよいフェニル基を示し、kは3~6の整数を示 し、h、i 及びj はそれぞれh ≥ 1 、i ≥ 0 及び j ≥ 1 を満たす整数を示し、Tは水素原子又は上記Rを示し、 Tが上記Rであるとき、hはh≥3を満たす整数を示 す。)で表わされるパーフルオロブタジエニル基含有オ ルガノヒドロポリシロキサンである請求項1に記載の紫 20 オロブタジエニル芳香族化合物、 外線感光性含フッ素シリコーン組成物。

【請求項6】(a) 一般式(1)

40

(式中、R1 はアルケニル基を示し、Rは相互に同一で ルオロアルキル基か、(ポリ)オキシフルオロアルキレ ンオキシアルキレン基か、又はアルキル基を置換基とし て有していてもよいフェニル基を示し、xは1又は2の 整数を示し、p及びqはそれぞれp≥0及びq≥0を満 たす整数を示す。)で表わされるアルケニル型オルガノ ポリシロキサン、

(c) 一般式(III)

(式中、Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数 1~8のアルキル基か、又はアルキル基を置換基として 有していてもよいフェニル基を示し、h及びiはそれぞ れh≥1及Ui≥0を満たす整数を示し、Tは水素原子※

$$\begin{pmatrix} F_2C = CF \\ CF_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} CF_3 \\ m \end{pmatrix}$$

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合し ている炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子 に水素原子が結合しているm価の芳香族炭化水素基を示 し、mは1以上の整数を示す。) で表わされるパーフル

(b) 一般式 (II)

※又は上記Rを示し、Tが上記Rであるとき、hはh≥3 も異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、フ 30 を満たす整数を示す。)で表わされるオルガノヒドロポ リシロキサン、及び

> (d) ケイ素原子に結合したアルケニル基の水素原子を有 するケイ素原子への付加反応に対する触媒を含む請求項 1に記載の紫外線硬化性含フッ素シリコーン組成物。

【請求項7】(a) 一般式(1)

【化9】

$$\begin{pmatrix}
F_2C = CF \\
CF_3
\end{pmatrix} = CF_3$$

$$\begin{pmatrix}
CF_3
\end{pmatrix} = CF_3$$

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合し ている炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子 に水素原子が結合しているm価の芳香族炭化水素基を示 し、mは1以上の整数を示す。) で表わされるパーフル オロブタジエニル芳香族化合物、

(b) 一般式 (IV)

【化10】

3

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合し に水素原子が結合している2価の芳香族炭化水素基を示 す。R1 はアルケニル基を示し、Rは相互に同一でも異 なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又はア ルキル基を置換基として有していてもよいフェニル基を 示し、kは3~6の整数を示し、xは1又は2の整数を*

*示し、p、q及びrはそれぞれp≥0、q≥0及びr≥ ている炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子 10 1を満たす整数を示す。)で表わされるパーフルオロブ タジエニル基含有アルケニル型オルガノポリシロキサ

(c) 一般式 (V)

【化11】

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合し ている炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子 に水素原子が結合している2価の芳香族炭化水素基を示 す。Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~ 8のアルキル基か、又はアルキル基を置換基として有し ていてもよいフェニル基を示し、kは3~6の整数を示 し、h、i及びjはそれぞれ $h \ge 1$ 、 $i \ge 0$ 及び $j \ge 1$ 30 物。 を満たす整数を示し、Tは水素原子又は上記Rを示し、 Tが上記Rであるとき、hはh≥3を満たす整数を示 す。) で表わされるパーフルオロブタジエニル基含有オ ルガノヒドロポリシロキサン、及び

※(d) ケイ素原子に結合したアルケニル基の水素原子を有 するケイ素原子への付加反応に対する触媒を含む請求項 1に記載の紫外線硬化性含フッ素シリコーン組成物。 【請求項8】アルケニル型オルガノポリシロキサン(b) におけるアルケニル基がビニル基である請求項2、4、 6又は7に記載の紫外線硬化性含フッ素シリコーン組成

【請求項9】アルケニル型オルガノボリシロキサン(b) が一般式(VIII)

【化12】

$$R \qquad CH = CH_2 \qquad R \qquad R$$

$$CH_2 = CH - SiO - [-SiO -]_P - [-SiO -]_Q - Si - CH = CH_2$$

$$R \qquad R \qquad R$$

$$(VIII)$$

(式中、Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数 1~8のアルキル基か、フルオロアルキル基か、(ボ リ) オキシフルオロアルキレンオキシアルキレン基か、 又はアルキル基を置換基として有していてもよいフェニ ル基を示し、p及びqはそれぞれp≥0及びq≥0を満★

★たす整数を示す。) で表わされる請求項6に記載の紫外 線感光性含フッ素シリコーン組成物。

【請求項10】パーフルオロブタジエニル基含有アルケ ニル型オルガノポリシロキサン(b) が一般式 (XVII) 【化13】

(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合しないる炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子 10 に水素原子が結合している2価の芳香族炭化水素基を示す。Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又はアルキル基を置換基として有していてもよいフェニル基を示し、kは3~6の整数を示し、p、q及びrはそれぞれp≥0、q≥0及びr≥1を満たす整数を示す。)で表わされる請求項7に記載の紫外線感光性含フッ素シリコーン組成物。

【請求項11】Arが置換基を有していてもよい単環式 又は多環式の1価の芳香族炭化水素基である請求項1、 4~7又は10のいずれかに記載の紫外線感光性含フッ 20 素シリコーン組成物。

【請求項12】Arが置換基を有していてもよい単環式 又は多環式の2価の芳香族炭化水素基である請求項1、 4~7又は10のいずれかに記載の紫外線感光性含フッ 素シリコーン組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、紫外線感光性含フッ素シリコーン組成物に関し、詳しくは、紫外線感光性の不飽和フルオロカーボン基として、分子中に少なくと 30も1個のパーフルオロブタジエニル基を有する芳香族化合物と共に、分子中に少なくとも2個のアルケニル基を有するオルガノポリシロキサンと分子中に少なくとも3個の水素原子を有するオルガノポリシロキサンと触媒とを含み、紫外線に対する感光性材料として有用である含フッ素シリコーン組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】ケイ素をボリマーの主鎖に含むボリシランが紫外線に対して感光性を有するこは、従来、既によく知られている。即ち、ボリマー主鎖の骨格であるSi 40 - Si結合が紫外線によってラジカル的に切断され、空気中の水分又は酸素と反応して、分子鎖末端にSi-〇日基等が生成して、化学構造が変化し、かくして、紫外線照射の前後でポリマー物性に差異が生じる。このような性質の変化を利用することによって、ポリシランをボジ型のフォトレジストとして用いることができることが知られている。例えば、このようなポリシランの応用として、液晶カラーフィルターの製造工程の簡略化に用いた例が知られている(「日経マイクロデバイス」1994年7月号第90頁)。 *50

* [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述したようなポリシランの紫外線に対する感光のための最低の照射エネルギー感度が約4J/cm²と高く、その実用化の面から、感度の向上が求められている。本発明は、従来の感光性ポリシランにおける上述したような問題を解決するためになされたものであって、紫外線に対して高感度を有する紫外線感光性の含フッ素シリコーン組成物を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明による紫外線感光 性含フッ素シリコーン組成物は、(a) 一般式(I)

[0005]

$$\begin{pmatrix}
F_2C - CF \\
CF_3
\end{pmatrix} = CF_3$$
(1)

【0006】(式中、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合している炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子に水素原子が結合しているm価の芳香族炭化水素基を示し、mは1以上の整数を示す。)で表わされるパーフルオロブタジエニル芳香族化合物、(b)分子中にケイ素に結合したアルケニル基を少なくとも2個有するアルケニル型オルガノボリシロキサン、(c)分子中にケイ素に結合した水素原子を少なくとも3個有するオルガノヒドロボリシロキサン、及び(d)ケイ素原子に結合したアルケニル基の水素原子を有するケイ素原子への付加反応に対する触媒を含むことを特徴とする。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明による紫外線感光性含フッ素シリコーン組成物において、成分(a) は、前記一般式(I)で表わされる分子中にパーフルオロブタジエニル基を少なくとも1個有する芳香族炭化水素である。本発明において、〔Z〕-1,1,2,5,5,5,5-ヘキサフルオロー3-トリフルオロメチル-1,3-ペンタジエン-4-イル基を簡単のために、パーフルオロブタジエニル基という。

【0008】ここに、前記一般式(I)において、Arは、パーフルオロブタジエニル基が結合している炭素原*50 子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子に水素原子が

結合しているm価の単環式又は多環式の芳香族炭化水素 基を示す。mは1以上の整数を示し、好ましくは、1又 は2である。即ち、Arは、単環式又は多環式の2価の 芳香族炭化水素基を示す。

【0009】このようなArの好ましい具体例として は、mが1であるとき、例えば、フェニル基、ナフチル 基、ビフェニルイル基、フェナントリル基、アントリル 基等を挙げることができるが、これらに限定されるもの ではない。しかし、本発明においては、原料の入手の容 ェニル基又はナフチル基であることが好ましい。

【0010】これらの1価の芳香族炭化水素基は、後述 するようなパーフルオロブタジエニル基の光環化反応を 阻害しない限りは、芳香環上に不活性な置換基を有して いてもよい。このような不活性な置換基としては、例え ば、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、フルオ ロアルキル基、水酸基、ニトロ基等を挙げることができ る。また、芳香族炭化水素基は、アリルオキシ基を有し ていてもよい。

【0011】このようなアルキル基としては、例えば、 メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブ チル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル 基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル等を、アルコキ シ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロ ポキシ基、イソプロポキシ基、ブチロキシ基、イソブチ ロキシ基、sec-ブチロキシ基、t-ブチロキシ基、 ペンチロキシ基、ヘキシロキシ基、オクチロキシ基等 を、ハロゲン原子としては、塩素や臭素やフッ素原子 を、フルオロアルキル基としては、例えば、トリフルオ 族炭化水素基は、アリルオキシ基を有していてもよい。 【0012】また、Arの好ましい具体例として、mが 2であるとき、例えば、フェニレン基、ナフチレン基、 ビフェニレン基、フェナントリレン基、アントリレン 基、一般式(VI)

【0019】(式中、R1 はアルケニル基を示し、Rは 相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~8のアル キル基か、フルオロアルキル基か、(ポリ)オキシフル オロアルキレンオキシアルキレン基か、又はアルキル基 を置換基として有していてもよいフェニル基を示し、x は1又は2の整数を示し、p及びqはそれぞれp≥0及 び q ≥ 0 を満たす整数を示す。) で表わされるものを挙 げることができる。

【0020】上記炭素数1~8のアルキル基としては、※50 例えば、3,3,3-トリフルオロプロピル基を例示するこ

* [0013] 【化15】

10

【0014】(式中、Xは、メチレン基等のアルキレン 基又はアルキリデン基、O、S、SO2等を示す。)で 表わされる基等を挙げることができるが、これらに限定 易さから、1価の芳香族炭化水素基としては、特に、フ 10 されるものではない。しかし、本発明においては、原料 の入手の容易さから、2価の芳香族炭化水素基として は、特に、フェニレン基、ナフチレン基、ビフェニルイ ル基、又はジフェニルエーテルー4,4'ージイル基である ことが好ましい。

> 【0015】これらの2価の芳香族炭化水素基も、後述 するようなパーフルオロブタジエニル基の光環化反応を 阻害しない限りは、前述したような不活性な置換基を芳 香環上に有していてもよい。また、アリルオキシ基を有 していてもよい。

20 【0016】従って、本発明において、特に、好ましい 成分(a) の具体例として、例えば、パーフルオロブタジ エニルベンゼン、パーフルオロブタジエニルナフタレ ン、4-アリルオキシパーフルオロブタジエニルベンゼ ン、4-アリルオキシパーフルオロブタジエニルナフタ レン、4.4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ビフェ ニル、4,4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ジフェ ニルエーテル等を挙げることができる。

【0017】本発明による紫外線感光性含フッ素シリコ ーン組成物において、成分(b) は、分子中にケイ素に結 ロメチル基等を挙げることができる。また、1価の芳香 30 合したアルケニル基を少なくとも2個有するアルケニル 型オルガノポリシロキサンである。本発明においては、 このようなアルケニル型オルガノポリシロキサン(b) の 好ましい一例として、一般式(II)

※例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピ ル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、t -ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル等を挙 げることができる。また、アルキル基を置換基として有 しているフェニル基としては、例えば、トルイル基、キ シリル基、ベンジル基等を挙げることができるが、これ らに限定されるものではない。

【0021】また、上記フルオロアルキル基としては、

とができ、また、(ポリ)オキシフルオロアルキレンオ キシアルキレン基として、例えば、一般式 (VII)

【0023】(式中、kは3~6の整数を示し、wは1 10 【0026】 ~3の整数を示す。)で表わされる基を例示することが できるが、しかし、フルオロアルキル基や(ポリ)オキ*

*シフルオロアルキレンオキシアルキレン基は、これら例 示したものに限定されるものではない。

12

【0024】本発明においては、成分(b) は、好ましく は、アルケニル基を分子中に少なくとも2個有する直鎖 状のポリシロキサンであり、更に、アルケニル基は、実 用上、ビニル基又はアリル基であることが好ましく、特 に、ビニル基であることが好ましい。

【0025】従って、本発明において、特に、好ましい 成分(b) として、一般式 (VIII)

【化18】

$$R \qquad CH = CH_{z} \qquad R \qquad R$$

$$CH_{z} = CH_{z} = CH_{z} = CH_{z} = CH_{z}$$

$$CH_{z} = CH_{z} = CH_{z} = CH_{z}$$

$$H_{z} = CH_{z} = CH_{z} = CH_{z}$$

$$H_{z} = CH_{z} = CH_{z} = CH_{z}$$

$$H_{z} = CH_{z} = CH_{$$

【0027】(式中、Rは相互に同一でも異なっていて 基か、(ポリ)オキシフルオロアルキレンオキシアルキ レン基か、又はアルキル基を置換基として有していても よいフェニル基を示し、p及びqはそれぞれp≧0及び q≥0を満たす整数を示す。) で表わされる末端ビニル 基停止オルガノポリシロキサンを挙げることができる。 【0028】ここに、Rの具体例としては、前記一般式 (II) で表わされるアルケニル型オルガノポリシロキサ ンにおいて例示したものと同じものを挙げることができ る。次に、本発明による紫外線感光性含フッ素シリコー した水素原子を少なくとも3個有するオルガノヒドロポ リシロキサンである。

【0029】本発明において、このようなオルガノヒド ロポリシロキサンの好ましい一例として、例えば、一般 式(III)

※【0031】(式中、Rは相互に同一でも異なっていて もよい炭素数1~8のアルキル基か、フルオロアルキル 20 もよい炭素数1~8のアルキル基か、又はアルキル基を 置換基として有していてもよいフェニル基を示し、h及 Videantial Uit i = 0を満たす整数を示し、 Tは水素原子又は上記Rを示し、Tが上記Rであると き、hはh≥3を満たす整数を示す。)で表わされる。 【0032】ここに、上記炭素数1~8のアルキル基と しては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イ ソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec‐ブチ ル基、セーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチ ル等を挙げることができる。また、アルキル基を置換基 ン組成物において、成分(c) は、分子中にケイ素に結合 30 として有しているフェニル基としては、例えば、トルイ ル基、キシリル基、ベンジル基等を挙げることができる が、これらに限定されるものではない。

> 【0033】更に、本発明によれば、前記アルケニル型 オルガノポリシロキサン(b) の別の好ましい一例とし て、一般式(IV)

[0034] 【化20】

【0035】(式中、Arは、パーフルオロブタジエニ 位の炭素原子に水素原子が結合している 2 価の芳香族炭 化水素基を示す。R1 はアルケニル基を示し、Rは相互 に同一でも異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル 基か、又はアルキル基を置換基として有していてもよい フェニル基を示し、kは3~6の整数を示し、xは1又 は2の整数を示し、p、q及びrはそれぞれp≥0、q ≥0及び r≥1を満たす整数を示す。) で表わされるパ ーフルオロブタジエニル基含有アルケニル型オルガノポ リシロキサンを挙げることができる。

【0036】ここに、Arは、2価の芳香族炭化水素基 20 らに限定されるものではない。 であって、その好ましい具体例としては、前述したよう に、例えば、フェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレ ン基、フェナントリレン基、アントリレン基、前記一般 式(VI)で表わされる基等を挙げることができるが、こ れらに限定されるものではない。しかし、本発明におい ては、原料の入手の容易さから、2価の芳香族炭化水素 基としては、特に、フェニレン基、ナフチレン基、ビフ ェニルイル基、又はジフェニルエーテルー4.4'ージイル 基であることが好ましい。

【0037】これらの2価の芳香族炭化水素基も、後述*30

* するようなパーフルオロブタジエニル基の光環化反応を ル基が結合している炭素原子の少なくとも1つのオルト 10 阻害しない限りは、前述したような不活性な置換基を芳 香環上に有していてもよい。また、芳香族炭化水素基 は、アリルオキシ基を有していてもよい。

> 【0038】上記炭素数1~8のアルキル基としては、 例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピ ル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、t ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル等を挙 げることができる。また、アルキル基を置換基として有 しているフェニル基としては、例えば、トルイル基、キ シリル基、ベンジル基等を挙げることができるが、これ

> 【0039】本発明においては、成分(b) は、好ましく は、アルケニル基を分子中に少なくとも2個有する直鎖 状のポリシロキサンであり、更に、アルケニル基は、実 用上、ビニル基又はアリル基であることが好ましく、特 に、ビニル基であることが好ましい。従って、本発明に おいて、特に、好ましい成分(b) の別の一例として、一 般式 (XVII)

[0040] 【化21】

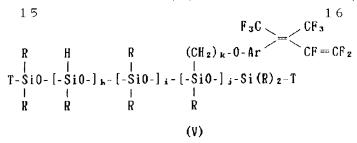
【0041】(式中、Arは、パーフルオロブタジエニ 位の炭素原子に水素原子が結合している 2価の芳香族炭 化水素基を示す。Rは相互に同一でも異なっていてもよ い炭素数1~8のアルキル基か、又はアルキル基を置換 基として有していてもよいフェニル基を示し、kは3~ 6の整数を示し、xは1又は2の整数を示し、p、q及 びrはそれぞれp≥0、q≥0及びr≥1を満たす整数 を示す。) で表わされるパーフルオロブタジエニル基含 有アルケニル型ポリシロキサンを挙げることができる。※

※【0042】ここに、Ar及びRの具体例としては、前 ル基が結合している炭素原子の少なくとも1つのオルト 40 記一般式(IV)で表わされるパーフルオロブタジエニル 基含有アルケニル型オルガノポリシロキサンにおいて例 示したものと同じものを挙げることができる。

> 【0043】また、本発明において、オルガノヒドロポ リシロキサン(c) の別の好ましい一例として、例えば、 一般式(V)

[0044]

【化22】



【0045】(式中、Arは、パーフルオロブタジエニ ル基が結合している炭素原子の少なくとも1つのオルト 10 【化24】 位の炭素原子に水素原子が結合している2価の芳香族炭 化水素基を示す。Rは相互に同一でも異なっていてもよ い炭素数1~8のアルキル基か、又はアルキル基を置換 基として有していてもよいフェニル基を示し、kは3~ 6の整数を示し、h、i 及び j はそれぞれ h ≥ 1 、i ≥ O及びj≥1を満たす整数を示し、Tは水素原子又は上 記Rを示し、Tが上記Rであるとき、hはh≥3を満た す整数を示す。) で表わされるパーフルオロブタジエニ ル基含有オルガノヒドロポリシロキサンを挙げることが できる。

【0046】Arの好ましい具体例として、例えば、フ ェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基、フェナン トリレン基、アントリレン基、ジフェニルエーテルー4、 4'-ジイル基等を挙げることができるが、これらに限定 されるものではない。これらの2価の芳香族炭化水素基 も、後述するようなパーフルオロブタジエニル基の光環 化反応を阻害しない限りは、前述したような不活性な置 換基を芳香環上に有していてもよい。

【0047】また、上記炭素数1~8のアルキル基とし ては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソ 30 プロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec‐ブチル 基、t-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル 等を挙げることができる。また、アルキル基を置換基と して有しているフェニル基としては、例えば、トルイル 基、キシリル基、ベンジル基等を挙げることができる が、これらに限定されるものではない。

【0048】次に、本発明による紫外線感光性含フッ素 シリコーン組成物における上記各成分の製造について説 明する。前記一般式(I)で表わされるパーフルオロブ タジエニル芳香族化合物(a) は、一般式 (IX)

[0049]

【化23】

In-Ar (XI)

【0050】(式中、Arは、ヨウ素(I)が結合して いる炭素原子の少なくとも1つのオルト位の炭素原子に 水素原子が結合しているm価の芳香族炭化水素基を示 し、mは1以上の整数を示す。) で表わされる芳香族ヨ ウ素化合物と、一般式(X)

* [0051]

 $F_zC = CF$. (X)

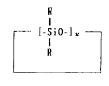
【0052】で表わされるパーフルオロブタジエニル銅 とのカップリング反応によって得ることができる。この カップリング反応においては、通常、上記パーフルオロ ブタジエニル銅化合物は、前記芳香族ヨウ素化合物のヨ ウ素に対して、1 当量以上、用いられる。ここに、上記 20 Arの具体例としては、前記一般式(I)で表わされる パーフルオロブタジエニル芳香族化合物において例示し たものと同じものを挙げることができる。

【0053】上記パーフルオロブタジエニル銅の調製 と、このようなパーフルオロブタジエニル銅と芳香族ヨ ウ素化合物との反応は、既に知られている(M. Yamamot o ら、アメリカ化学会フッ素化学分会第11回冬季フッ 素討論会発表(1993年)、M. Yamamoto ら、日本化 学会フッ素化学分会第15回フッ素討論会発表(199 4年))。

【0054】上記芳香族ヨウ素化合物とパーフルオロブ タジエニル銅とのカップリング反応においては、通常、 反応溶剤が用いられる。反応溶剤は、特に限定されるも のではないが、例えば、ジメチルホルムアミド、ジメチ ルアセトアミド、ヘキサメチルホスホルトリアミド等の アミド系溶剤が好ましく用いられる。また、カップリン グ反応の温度は、一般に、○℃以上、反応溶剤の沸点以 下であればよいが、好ましく、50~100℃の範囲で ある。

【0055】前記一般式(11)で表わされるアルケニル 40 型オルガノポリシロキサン(b) は、例えば、一般式(X I)

[0056] 【化25】



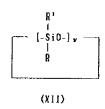
(XI)

【0057】(式中、Rは相互に同一でも異なっていて

もよい炭素数1~8のアルキル基か、又は炭素数1~4のアルキル基を有していてもよいフェニル基を示し、xは3~4の整数を示す。)で表わされるシクロシロキサンと、一般式(XII)

[0058]

【化26】



【0059】(式中、R1 はアルケニル基を示し、Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、フルオロアルキル基か、(ボリ)オキシフルオロアルキレンオキシアルキレン基か、又はアルキル基を置換基として有していてもよいフェニル基を示し、yは3~4の整数を示す。)で表わされるアルケニル基を有するシクロシロキサンと、一般式(XIII)

【0061】(式中、Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又はアルキル基を置換基として有していてもよいフェニル基を示し、vは 300又は1以上の整数である。)で表わされる末端R基停止オルガノシロキサンから、それぞれ目的に応じた適宜の割合にて、酸又はアルカリ触媒の存在下に平衡化反応によって重合させることによって得ることができる。

【0062】特に、前記一般式 (VIII) で表わされる末端ビニル基停止オルガノポリシロキサン(b) は、例えば、前記一般式 (XI) で表わされるシクロシロキサンと、一般式 (XIV)

[0063]

【化28】

$$R R R$$

$$CH_2 = CH - [-SiO-]_{W} - Si - CH = CH_2$$

$$R R$$

$$(XIV)$$

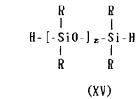
【0064】(式中、Rは相互に同一でも、異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又は炭素数1~4のアルキル基を有していてもよいフェニル基を示し、wは1以上の整数を示す。)で表わざれる末端ビニル基 50

18

停止オルガノシロキサンとをそれぞれ目的に応じた適宜の割合にて、酸又はアルカリ触媒の存在下に平衡化反応によって重合させることによって得ることができる。【0065】また、前記一般式(III)で表わされるオルガノボリシロキサン(c)は、例えば、前記一般式(XI)で表わされるシクロシロキサンと一般式(XV)

[0066]

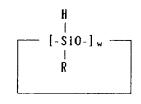
【化29】



【0067】(式中、Rは相互に同一でも、異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又は炭素数1~4のアルキル基を有していてもよいフェニル基を示し、zは1以上の整数を示す。)で表わされるヒドロ基含有シロキサンと一般式(XVI)

20 [0068]

【化30】



(XVI)

【0069】(式中、Rは相互に同一でも、異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又は炭素数1~4のアルキル基を有していてもよいフェニル基を示し、wは3以上の整数を示す。)で表わされるヒドロ基含有シクロシロキサンをそれぞれ目的に応じた適宜の割合にて平衡化反応によって重合させることによって得ることができる。

【0070】他方、前記一般式(XVII)で表わされるパーフルオロブタジエニル基含有末端ビニル基停止オルガノポリシロキサン(b) は、例えば、一般式(XVIII)

40 [0071]

【化31】

20

$$\begin{array}{c}
 & 19 \\
 & F_3C \\
 & (CH_2)_{k} - 0 - A_T
\end{array} = CF_3$$

$$\begin{array}{c}
 & CF = CF \\
 & R
\end{array}$$
(XVIII)

【0072】(式中、Arは2価の芳香族炭化水素基を示し、Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又は炭素数1~4のアルキル基を有していてもよいフェニル基を示し、kは3~6の整数を示し、gは3~10の整数を示す。)で表わされる含フッ素シクロポリシロキサンと、一般式(XIX)

【0073】 【化32】

$$R R R | R | CH_2 = CH - [-SiO-]_w - Si - CH = CH_2$$

$$R R | R | CH_2 = CH_2 | CH_2 | CH_2$$

$$R R | R | CXIX$$

【0074】(式中、wは1以上の整数を示し、Rは相互に同一でも、異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又は炭素数1~4のアルキル基を有していてもよいフェニル基を示す。)で表わされる末端ビニル基停止オルガノシロキサンとをそれぞれ目的に応じた適宜の割合にて、酸又はアルカリ触媒の存在下に平衡化反応 30によって重合させることによって得ることができる。

【0075】ここに、本発明によれば、前記一般式 (XV III)で表わされる含フッ素シクロポリシロキサンのなかでも、一般式 (XX)

【0076】 【化33】

$$\begin{array}{c|c}
 & F_3C \\
\hline
R & CF = CF_2 \\
0 & 0 \\
R & | R \\
\hline
R & Si \\
R
\end{array}$$

【0077】(式中、Arは2価の芳香族炭化水素基を示し、Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又は炭素数1~4のアルキル基を有していてもよいフェニル基を示し、kは3~6の整数を示す。)で表わされる含フッ素シクロトリシロキサン 50

(XX)

20

が平衡化反応速度が大きい点から好ましく用いられる。 【0078】上記一般式(XX)で表わされる含フッ素シ クロトリシロキサンは、例えば、一般式(XXI)

【0079】 【化34】



【0080】(式中、Rは相互に同一でも、異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又はアルキル基を置換基として有していてもよいフェニル基を示す。)で表わされるジシロキサンジオールと、一般式(XXII)

[0081]

[
$$AC35$$
]

C1

F₃C

R-Si-(CH_z)_k-0-Ar

CF= CF_z

(XXII)

【0082】(式中、Arは2価の芳香族炭化水素基を示し、Rは相互に同一でも異なっていてもよい炭素数1~8のアルキル基か、又は炭素数1~4のアルキル基を有していてもよいフェニル基を示し、kは3~6の整数を示す。)で表わされるジクロロシラン化合物とをトリエチルアミン等のような第三級アミンの存在下で反応させることによって、得ることができる。

【0083】更に、上記一般式(XXII)で表わされるジ クロロシラン化合物は、一般式(XXIII)

[0084]

[
$$\ell$$
136]
 $CF_z = CF$

$$CF_3$$

$$Ar - 0 - (CH_z)_{k-2} - CH = CH_2$$

(XXIII)

【0085】(式中、Arは、パーフルオロブタジエニ 40 ル基が結合している炭素原子の少なくとも1つのオルト 位の炭素原子に水素原子が結合している2価の芳香族炭 化水素基を示す。kは3~6の整数を示す。)で表わされるパーフルオロブタジエニル基を有するアルケニル化 合物と、一般式(XXIV)

【0086】 【化37】



【0087】(式中、Rは相互に同一でも、異なってい てもよい炭素数1~8のアルキル基か、又はアルキル基 を置換基として有していてもよいフェニル基を示す。) で表わされるジクロロヒドロシランから白金系触媒を用 としては、例えば、塩化白金酸のほか、塩化白金酸と各 種オレフィンとの錯化合物等を挙げることができる。

【0088】前記一般式 (XXIII)で表わされるパーフル オロブタジエニル基を有するアルケニル化合物は、前述 したように、例えば、一般式 (XXV)

[0089]

【化38】

$$I - Ar - 0 - (CH_2)_{k-2} - CH = CH_2$$

 $(\chi\chi\chi)$

【0090】(式中、Arは、パーフルオロブタジエニ ル基が結合している炭素原子の少なくとも1つのオルト 位の炭素原子に水素原子が結合している2個の芳香族炭 化水素基を示す。kは3~6の整数を示す。)で表わさ れるアルケニル芳香族ヨウ素化合物と、一般式 (X)で表 わされるパーフルオロブタジエニル銅とのカップリング 反応によって得ることができる。

【0091】次に、前記一般式(V)で表わされるパーフ ルオロブタジエニル基含有オルガノヒドロポリシロキサ ンは、例えば、前記一般式(XX)で表わされる含フッ素 30 シクロトリシロキサンと、一般式 (XXVI)

[0092]

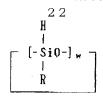
【化39】

(XXVI)

【0093】(式中、zは1以上の整数を示し、Rは相 40 互に同一でも、異なっていてもよい炭素数1~8のアル キル基か、又はアルキル基を置換基として有していても よいフェニル基を示す。)で表わされるヒドロ基含有オ ルガノポリシロキサンと、一般式 (XXVII)

[0094]

【化40】



(IIVXX)

【0095】(式中、wは3以上の整数を示し、Rは炭 素数1~8のアルキル基か、又はアルキル基を置換基と いて容易に得ることができる。ここに、上記白金系触媒 10 して有していてもよいフェニル基を示す。)で表わされ るヒドロ基含有オルガノポリシロキサンとをそれぞれ目 的に応じた割合で酸又はアルカリを触媒として用いる公 知の平衡化反応によって重合させることによって得るこ とができる。

> 【0096】本発明による紫外線感光性含フッ素シリコ ーン組成物においては、上述した成分(b) と成分(c) と は、成分(b) のケイ素に結合したアルケニル基1個に対 して、成分(c) のケイ素に結合した水素原子が0.1~1 0個、好ましくは、1~3個となるような割合にて用い られる。また、成分(a) は、特に限定されるものではな いが、通常、成分(b) と(c) との合計量100重量部に 対して、10~300重量部の範囲で用いられる。

> 【0097】本発明による紫外線感光性含フッ素シリコ ーン組成物において、成分(d) であるケイ素原子に結合 したアルケニル基の水素原子を有するケイ素原子への付 加反応、即ち、架橋反応に対する触媒は、成分(b) と成 分(c) とを付加反応させるための触媒であって、例え ば、白金やロジウムや、また、それらから誘導される錯 体等を挙げることができる。そのような錯体としては、 例えば、ジビニル型シロキサンの白金錯体、アミノ基を 有するシロキサンの白金錯体等を挙げることができる。 本発明においては、このような触媒は、成分(b) と成分 (c) の合計重量に対して、自金換算にて、通常、1~1 0000ppmの範囲にて用いられる。

【0098】本発明による紫外線感光性含フッ素シリコ ーン組成物は、上述したような成分(a) 、(b) 、(c) 及 び(d) を好ましくはそれぞれ所定割合にて配合すること によって得ることができ、更に、必要に応じて、架橋活 性を安定化するために、触媒の安定化剤を配合してもよ い。また、本発明による紫外線感光性含フッ素有機シリ コーン組成物は、必要に応じて、含フッ素系溶剤や塩素 系溶剤等の適宜の有機溶剤にて希釈してもよい。このよ うな本発明による紫外線感光性含フッ素シリコーン組成 物は、用途に応じて、種々の基材に容易に塗布すること ができる。

【0099】前記一般式(I)で表わされるパーフルオ ロブタジエニル芳香族化合物(a)、正確には、〔Z〕-1,1,2,5,5,5ーヘキサフルオロー3ートリフルオロメチ ルー1,3ーペンタジエンー4ーイル基を有する芳香族化

50 合物に紫外線を照射することによって、次式

[0100]

【0101】(式中、乙は水素又はパラ位の塩素、トリ フルオロメチル基、メトキシ基又はメチル基を示す。) に示すように、芳香環の有するヘキサフルオロブタジエ ニル基のオルト位とヘキサフルオロブタジエニル基の末 端のジフルオロメチレン基とが光環化反応を起こして、 フッ化水素を脱離し、新たな芳香環を形成することは、 既に知られている (M. Yamamoto ら、アメリカ化学会フ ッ素化学分会第11回冬季フッ素討論会発表(1993 年〉)。

【0102】更に、オルガノポリシロキサンの主鎖骨格 であるSi-O結合は、ケイ素原子とフッ素原子との高 い親和性のために、フッ化水素によって切断されること 20 も、既に知られている。このことは、オルガノポリシロ キサンのフラグメント化分析法に広く用いられている。 【0103】そこで、本発明による紫外線感光性含フッ 素シリコーン組成物は、例えば、これを適宜の基材上に 塗布し、溶媒を乾燥させて、基材上に被膜を形成させ、 次いで、この被膜に紫外線を照射して、被膜を紫外線に 感光させ、化学変化を生じさせた後、被膜を加熱して、 成分(b) と(c) とを架橋させる。このようにして、本発 明による紫外線感光性含フッ素シリコーン組成物は、被 膜が紫外線に感光した部分、即ち、露光部においては、 物性の変化の結果として、上記架橋後においても、例え ば、塩基性有機溶剤に溶解性を有する。しかし、紫外線 に感光していない部分、即ち、未露光部では、被膜は、 例えば、塩基性有機溶剤に不溶性のままである。ここ に、成分(b) と成分(c) との上記架橋のための反応温度 は、特に、限定されるものではないが、通常、50~2 00℃の範囲であり、好ましくは、70~150℃の範 囲である。

【0104】より詳細には、本発明による紫外線感光性 照射すれば、前述したように、ヘキサフルオロブタジエ ニル基の光環化反応によってフッ化水素を発生し、この フッ化水素によって、ポリシロキサンの主鎖が切断され る結果として、その物性が変化するものとみられる。物 性の変化は、具体的には、分子量の減少、水酸基の出現 等であり、このような物性の変化によって、組成物の架 橋処理後においても、塩基性溶剤に溶解する。ポリシロ キサンの分子量の減少は、一般的な分子量測定によって 確認することができ、また、水酸基の出現は、赤外線吸 収分析法によって確認することができる。

※【0105】成分(b) 又は成分(c) がパーフルオロブタ 10 ジエニル基を有する場合は、成分(b) と成分(c) が上述 したように触媒の存在下で架橋するのみならず、成分

24

(b) 又は成分(c) が有するパーフルオロブタジエニル基 も、前述したように紫外線照射によって反応し、フッ化 水素を発生し、同様に、このフッ化水素によって、ポリ シロキサンの主鎖が切断されて、その物性が変化すると みられる。

【0106】上記塩基性有機溶剤としては、ポリシロキ サンの主鎖を切断するものや、未反応の含フッ素ブタジ エニル基や紫外線照射によって生成する芳香環を分解す るものでなければ、どのようなものでもよいが、特に、 好ましい塩基性有機溶剤として、例えば、第3級アミン や芳香族アミン等を挙げることができる。第3級アミン の具体例としては、例えば、トリエチルアミン、トリブ チルアミン、ジメチルエチルアミン、ジエチルメチルア ミン等を挙げることができる。

【0107】このような一般の有機溶剤としては、例え ば、クロロホルム、テトラヒドロフラン、塩化メチレ ン、ジエチルエーテル、N-メチル-2-ピロリドン、 ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ヘキサ 30 メチルホスホルトリアミド等を挙げることができる。 【0108】従って、本発明による紫外線感光性シリコ ーン組成物は、例えば、フォトレジストとして有用であ り、上述したような塩基性有機溶剤を所謂現像剤として 用いることができる。即ち、本発明による組成物の溶液 を適宜の基材上に塗布し、紫外線を照射して、これに感 光、即ち、露光させ、加熱処理し、この後、現像剤にて 現像して、露光部分を溶解、除去するのである。

【0109】本発明において用いることができる紫外線 は、波長が185~400 nmの領域にある通常のもの 含フッ素シリコーン組成物においては、これに紫外線を 40 でよいが、このなかでは、特に、254~365nmの 波長域が好ましい。このような波長域を有する光源とし ては、一般に市販されている高圧水銀灯や低圧水銀灯を 用いることができる。しかし、これら以外にも、紫外線 の光源として、エキシマレーザー等のレーザー光源を用 いることもできる。更に、必要に応じて、種々の紫外線 フィルターを用いて、特定の波長の紫外線を用いてもよ

[0110]

【発明の効果】以上のように、本発明による紫外線感光 ※50 性含フッ素シリコーン組成物は、これに紫外線を照射す

ることによって、高感度に感光するので、そのような性 質を利用して、例えば、フォトレジスト等として用いる ことができる。

[0111]

【実施例】以下に各成分の合成を示す参考例と共に実施 例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれら実施例 により何ら限定されるものではない。

【0112】参考例1

(パーフルオロブタジエニル銅の合成) ドライアイス/ イソプロパノールコンデンサー、窒素導入口、セプタム 10 を備えた500mL容量の三つ口フラスコに活性化した 亜鉛末(19g、290mol)と乾燥したジメチルホル ムアミド(300mL)を加えた。これにプロモトリフ ルオロエチレン (CF2=CFBr、沸点-2℃、16g)を 徐々に加え、発熱反応が始まるまで、ドライヤーで50 ~60℃に加熱し、反応を開始させた。残りのブロモト リフルオロエチレン(32g)を反応溶液の温度が40 ~50℃に保持される程度の速度で加えた後、室温で更 に攪拌した。終夜、反応させた後、未反応のブロモトリ フルオロエチレンを減圧除去した。

【0113】このようにして得た CF2=CF-ZnBr のジメ チルホルムアミド溶液をドライアイス/イソプロパノー ルコンデンサー、窒素導入口、セプタムを備えた500 mL容量の三つ口フラスコ中の臭化第一銅(CuBr、29. 4g、192mmol) に徐々に滴下した後、室温で20分 間攪拌した。このようにして得た CF2=CF-Cu のジメチ ルホルムアミド溶液にパーフルオロー2-ブチン(沸点 -25℃、33.0g、206 mol)を徐々に滴下した 後、室温で3時間攪拌した。この後、過剰のパーフルオ ロブタジエニルー2ーブチンを減圧留去して、目的とす 30 るパーフルオロブタジエニル銅のジメチルホルムアミド 溶液を得た(F-NMR収率62%)。

【0114】参考例2

(パーフルオロブタジエニルベンゼンの合成)参考例1 で調製したパーフルオロブタジエニル銅のジメチルホル ムアミド溶液 (0.8 mol/L、140 m L、112 mmol) にヨードベンゼン (16.3g、80mmol) を徐々に滴下 し、得られた混合物を70~80℃で3時間加熱攪拌し た。反応終了後、得られた反応混合物にエーテル(1) L)を加え、減圧下に不溶物を沪別した後、エーテル層 40 を水洗した。このエーテル層を無水硫酸マグネシウムで 乾燥させた後、エーテルをエバポレータで除去した。こ のようにして得た濃縮残渣をシリカゲルクロマトグラフ ィー(展開溶媒塩化メチレン/ヘキサン(1/1))で 精製することによって、目的とするパーフルオロブタジ エニルベンゼン (気-液クロマトグラフィー純度97 %)を得た。

 $[0115]^{19}F-NMR(CDC1_3):-59.6$ $(q, 3F, CF_3, Fa), -60.3(q, 3F, C$ F₃ , F_b), -99.1 (dd, 1F, cis-CF= 50 【0120】このようにして得たp-ヨードフェノキシ

26

 CF_2 , Fc), -111.9 (dd, 1F, trans $-CF = CF_2$, Fd), -165.4 (dd, 1F, C $F = CF_2$, Fe) (Jab=13Hz, Jcd=61 Hz, Jce=32Hz, Jde=117Hz)

[0116]

【化42】

(Fa)
$$(Fd) F > C = C$$

$$(Fc) F > (Fe)$$

$$(Fa) C = C$$

$$(Fb) C = C$$

 $[0117]^{1}H-NMR(CDC1_3):7.2-7.4$ (m, 5H)

¹³C-NMR (CDC 1₃): 153.2 (ddd, -C $F = CF_2$, $^1J = 294$, 280Hz, $^2J = 46H$ z), 148.3 (q, ϕ -CF (CF₃) = CF (CF $_3$) -, $_2^2$ J=32Hz), 131.9(s), 130.8 (s), 129.1 (s), 128.1 (s), 126.2 $(m, -CF (CF_3) = CF (CF_3) - CF =)$, 122.4 (ddd, $-CF=CF_2$, $^1J=236H$ z, ${}^{2}J=54$, 24Hz), 121.1 (q, CF₃, $^{1}J = 275Hz$), 120.9 (qm, CF₃, $^{1}J =$ 275Hz)

ガスクロマトグラフィー質量分析:320(M+,1) 3), 300 (M+ -HF, 17), 281 (13), $251 (M^{+} - CF_{3}, 100), 231 (42), 2$ 01 (83), 182 (74), 151 (37) [0118]

高分解能質量分析 (HRMS) (C12H5 F9): 実験値 320.0244

計算値 320.0248

フーリエ変換赤外分光法(CC14):3080(w, C-H), 1795 (s, $-CF_2 = C-$), 1630 (m), 1446 (s), 1321 (s), 1291 (s), 1238(s), 1218(s), 1214

(s), 1195 (s), 1182 (s), 1172 (s), 1132(s), 871(m), 843

(m), 710 (m) (cm^{-1})

【0119】参考例3

(p-ヨードアリルオキシベンゼンの合成)市販のp-ヨードフェノール (39g、177mmol) をテトラヒド ロフラン(200mL)に溶解させた。別に、室温下に カリウムtーブトキシド(23g、184mmol)をジメ チルスルホキシド(200mL)に溶解させ、これを前 記p-ヨードフェノールのテトラヒドロフラン溶液に加 え、室温で3時間攪拌して、対応するフェノキシドに誘 導した。

ドに臭化アリル($20\,\mathrm{mL}$ 、 $225\,\mathrm{mnol}$)を室温下に加え、更に、湯浴温度 $50\sim55\,\mathrm{C}$ で1時間加熱反応させた。得られた反応混合物をエーテル($1\,\mathrm{L}$)で希釈し、このエーテル層を水洗した。このエーテル層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させた後、エーテルをエバポレータで除去した。このようにして得た濃縮残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(展開溶媒塩化メチレン/ヘキサン(1/1))で精製することによって、目的とするp-1日ードアリルオキシベンゼン(1/1)を定量的に得た。

【0121】参考例4

(5-ヨード-1-アリルオキシナフタレンの合成) 5-アミノ-1-ナフトール (25.0g、157mol)を氷水 (250mL) /濃硫酸 (10.2mL) に懸濁させ、これに亜硝酸ナトリウム (10.8g、188mol)を徐々に滴下し、ジアゾニウム塩に誘導した。これにヨウ化カリウム (28.2g、188mol) 水溶液 (30mL)を氷冷下に加え、更に、銅粉末 (0.1g)を入れた。反応混合物を湯浴上、75~80℃で窒素による発泡が収まるまで加熱した。

【0122】このようにして得た反応混合物から不溶物を沪取し、減圧下、加熱乾燥機中で終夜、乾燥させた。得られた乾燥物に酢酸エチル(300mL)を加え、不溶物を沪別した。エバポレータで沪液から酢酸エチルを除去し、得られた濃縮残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(展開溶媒へキサン/酢酸エチル(5/1))で精製することによって、5-ヨード-1-ナフトール(2*

*6.0g、純度90%、収率61%)を得た。

【0123】この5-ヨード-1-ナフトール(26.0g、96.3 mol)をテトラヒドロフランに溶解させ、別に、室温下にカリウムセーブトキシド(12g、96 mol)をジメチルスルホキシド(100 m L)に溶解させ、これを前記5-ヨード-1-ナフトールのテトラヒドロフラン溶液に加え、室温で3時間攪拌して、対応するナフトキシドに誘導した。

【0124】このようにした得た5-ヨードナフトキシドに臭化アリル(10mL、116mmol)を室温下に加え、更に、湯浴温度50~55℃で1時間加熱反応させた。得られた反応混合物をエーテル(0.5L)で希釈し、このエーテル層を水洗した。このエーテル層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させた後、エーテルをエバボレータで除去した。このようにして得た濃縮残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(展開溶媒クロロホルム/ヘキサン(1/3))で精製することによって、目的とする5-ヨード-1-アリルオキシナフタレン(12.3g、収率41%)を得た。

20 【0125】参考例5~8

参考例3~4と同様にして、4,4′ージョードビフェニル 及び4,4′ージョードジフェニルエーテルを合成した。次 いで、以上に合成した芳香族ヨウ素化合物を原料として 用いて、参考例2と同様にして、表1に示すパーフルオ ロブタジエニル芳香族化合物を合成した。

[0126]

【表1】

3 - F 47		収率
ヨード化合物	芳香族化合物	(%)
1-	Rf —	76
A0-1	Rf — OA	78
	Rf	82
AÒ	AO	
1-(Rf - () R1	69
1	Rf - 0 - 0 - 5	Rf 74
		$I \longrightarrow OA$ $Rf \longrightarrow OA$ AO $Rf \longrightarrow OA$ AO $Rf \longrightarrow OA$

(注) Aはアリル基を示し、Rfはパーフルオロブタジェニル基を示す。

外線吸収スペクトルを図2に、また、フッ素NMRスペ クトルを図3に示す。5-パーフルオロブタジエニルナ フチルアリルエーテルのプロトンNMRスペクトルを図 4に、赤外線吸収スペクトルを図5に、ガスクロマトグ ラフイー質量分析スペクトルを図6に、また、フッ素N MRスペクトルを図7に示す。

【0128】4,4'ービス(パーフルオロブタジエニル) ビフェニルのプロトンNMRスペクトルを図8に、赤外 線吸収スペクトルを図9に、ガスクロマトグラフイー質 量分析スペクトルを図10に、また、フッ素NMRスペ 10 クトルを図11に示す。4,4'-ビス(パーフルオロブタ ジエニル) ジフェニルエーテルのプロトンNMRスペク トルを図12に、赤外線吸収スペクトルを図13に、ガ スクロマトグラフイー質量分析スペクトルを図14に、 また、フッ素NMRスペクトルを図15に示す。

【0129】参考例9

A) アルケニル型オルガノポリシロキサンの合成(ポリ マー化)

市販の1,3,5ートリス(3,3,3ートリフルオロプロピ (0.86g)2.00mol)と市販のヘキサメチルトリシロキサン(2. 32g、4.00mmol)とにジビニルシロキサン(15.8 mg、0.085mmol)を加えた。この混合物に室温下に 硫酸(7mg)を滴下し、終夜、攪拌した。

【0130】反応終了後、得られた反応混合物にトルエ ン(10mL)を加え、トリエチルアミンにて反応系を 中和し、生成した白色の不溶物(トリエチルアミン硫酸 塩)を沪別した。得られた沪液から溶剤と未反応物をス トリッピング (1 mmHg、80°C) で除去して、目的 とする分子両末端にビニル基を有する含フッ素オルガノ 30 ポリシロキサン(以下、ビニルオイルという。)を得 た。計算分子量Mw=20800、官能基数Vi=2で ある。

B) Si-H基を有するオルガノヒドロポリシロキサン の合成(ポリマー化)

市販の1,3,5ートリス(3,3,3ートリフルオロプロピ (0.86g)ル) -1,3,5-トリメチルトリシロキサン (0.86g)2.00 mmol)と市販のヘキサメチルトリシロキサン(1. 16g、2.00mmol)とテトラメチルジシロキサン(3 1.4 mg、0.234 mmol) とテトラメチルテトラシロキ 40 サン (52.9 mg、0.220 mmol) とを混合し、この混 合物に室温下に硫酸(7mg)を滴下し、終夜、攪拌し た。

【0131】反応終了後、得られた反応混合物にトルエ ン(10mL)を加え、トリエチルアミンにて反応系を 中和し、生成した白色の不溶物(トリエチルアミン硫酸 塩)を沪別した。得られた沪液から溶剤と未反応物をス トリッピング(1mmHg、80℃)で除去して、目的 とするSiーH結合を有する含フッ素オルガノヒドロポ 3.0

算分子量Mw=5950、官能基(Si-H)数=5.8 である。

【0132】参考例10

(パーフルオロブタジエニル基含有アルケニル型オルガ ノポリシロキサンの合成)

A) パーフルオロブタジエニルフェニルアリルエーテル の合成

前記パーフルオロブタジエニル銅のジメチルスルホキシ ド溶液 (0.8M/L、140mL、112mmol) に前記 p-ヨードアリルオキシベンゼン(20.8g、80mmo 1)を徐々に滴下し、得られた反応混合物を70~80 ℃で3時間加熱攪拌した。

【0133】得られた反応混合物にエーテル(1L)を 加え、不溶物を減圧下に沪別し、得られたエーテル層を 水洗し、これを無水硫酸マグネシウムで表わされる乾燥 した後、エーテルをエバポレータで除去した。このよう にして得た濃縮残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (展開溶媒塩化メチレン/ヘキサン(1/1))で精製 することによって、目的とするパーフルオロブタジエニ ルフェニルアリルエーテル (30.1g) を定量的に得

【0134】B) パーフルオロブタジエニルフェニルオ キシプロピルジクロロシラン体の合成

上記パーフルオロブタジエニルフェニルアリルエーテル (6.2g、16mmol)を20mL容量三つ口茄子型フラ スコに仕込み、これに塩化白金酸(30mg)を加え、 70℃に加熱して溶解させた。次いで、これにヒドロシ リルジクロライド (1.9g、16mol)を徐々に加え、 そのまま、70℃で3時間、反応させて、目的とするパ ーフルオロブタジエニルフェニルオキシプロピルジクロ ロシラン体の粗生成物(7.0g)を得た。

【0135】C) パーフルオロブタジエニルベンゼン型 トリシロキサンの合成

トリエチルアミン(4.0 m L、29 mmol)のトルエン (60mL)溶液に上記パーフルオロブタジエニルフェ ニルオキシプロピルジクロロシラン体(7.0g、14.3) mmol)のトルエン(60mL)溶液とジシロキサンジオ ール (2.4g、14.4mol) のメチルエチルケトン (6 0 m L)溶液とを室温下に同じ滴下速度にて徐々に加 え、3時間室温で撹拌した後に、白色の不溶物(トリエ チルアミン塩酸塩)を沪去した。

【0136】得られた反応溶液にエーテル(500m し)を加え、エーテル層を水洗し、このエーテル層を無 水硫酸マグネシウムで乾燥させた後、エーテルをエバポ レータにて除去し、得られた濃縮残渣をシリカクロマト グラフイー(展開溶媒塩化メチレン/ヘキサン(1/ 1)で精製して、目的とするパーフルオロブタジエニル ベンゼン型トリシロキサンを得た(5.8g、純度99 %、2段階収率73%)。パーフルオロブタジエニルベ リシロキサン(以下、水素オイルという。)を得た。計 50 ンゼン型トリシロキサン体のプロトンNMRスペクトル

を図16に、赤外線吸収スペクトルを図17に、フッ素 NMRスペクトルを図18に、また、その拡大スペクト ルを図19に示す。

31

【0137】D) パーフルオロブタジエニル基含有アル ケニル型オルガノポリシロキサンの合成(ポリマー化) 上記パーフルオロブタジエニルベンゼン型トリシロキサ ン(1.16g、2.00mmol) にジビニルジシロキサン (15.8mg、0.085mmol)を加え、これに硫酸(7 mg)を室温下に滴下し、終夜、攪拌した。この後、反* * 応混合物にトルエン(10mL)を加え、トリエチルア ミンにて反応系を中和し、生成した白色の不溶物(トリ エチルアミン塩酸塩)を沪去した。溶媒と未反応物をス トリッピング (1mmHg、80℃) で除去して、分子 の両末端にビニル基を有するパーフルオロブタジエニル 基含有含フッ素アルケニル型オルガノポリシロキサン (以下、ビニルオイルという。)を得た。計算分子量M w=14000、官能基数Vi=2である。

32

[0138]

元素分析值:

実測値 C: 38.47%、H:4.77%、F: 30.02% 計算値 C: 38.69%、H:4.54%、F: 30.21%

このビニルオイルのプロトンNMRスペクトルを図20 に、赤外線吸収スペクトルを図21に、また、フッ素N MRスペクトルを図22に示す。E) Si-H基を有す るパーフルオロブタジエニル基含有オルガノヒドロポリ シロキサンの合成(ポリマー化)

【0139】前記パーフルオロブタジエニルベンゼン型 トリシロキサン (0.58g、1.00mmol) にヘキサメチ ルジシロキサン (31.4 mg、0.234 mmol)とテトラ 20 た。計算分子量Mw=2850、官能基 (Si-H)数 メチルテトラシロキサン (52.9g、0.220mmol)を 加え、これに硫酸(7mg)を室温で滴下し、終夜、攪※

※拌した。この後、得られた反応混合物にトルエン(10 mL)を加え、トリエチルアミンにて反応系を中和し、 生成した白色の不溶物 (トリエチルアミン硫酸塩)を沪 去した。溶媒と未反応物をストリッピング(1mmH g、80℃)で除去して、目的とするSi-H基を有す るパーフルオロブタジエニル基含有含フッ素オルガノヒ ドロポリシロキサン(以下、水素オイルという。)を得 =5.8である。

元素分析值:

実測値 C: 37.70%、H:5.23%、F: 26.97% 計算値 C: 37.81%、H:5.06%、F: 27.18%

この水素オイルのプロトンNMRスペクトルを図23 に、赤外線吸収スペクトルを図24に、また、フッ素N MRスペクトルを図25に示す。

【0140】参考例11

型オルガノポリシロキサンの合成)

A) パーフルオロブタジエニルナフチルアリルエーテル の合成

前記パーフルオロブタジエニル銅のジメチルスルホキシ ド溶液 (0.7 M/L、80 m L、56 mmol) に前記5-ヨードー1ーアリルオキシナフタレン(12.3g、40 mmol)を徐々に滴下し、得られた反応混合物を70~8 0℃で3時間加熱攪拌した。

【0141】得られた反応混合物にエーテル(0.5L) を加え、不溶物を減圧下に沪別し、得られたエーテル層 40 を水洗し、これを無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、 エーテルをエバポレータで除去した。このようにして得 た濃縮残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(展開溶媒 クロロホルム/ヘキサン(1/3))で精製することに よって、目的とする5ーパーフルオロブタジエニルナフ チルー1-アリルエーテル (6.7g、収率43%) を得

【0142】B) パーフルオロブタジエニルナフチルオ キシプロピルジクロロシラン体の合成

上記5ーパーフルオロブタジエニルナフチルー1-アリ★50 【0144】 このパーフルオロブタジエニルナフタレン

★ルエーテル (6.4g、16mmol) を20m L容量三つ口 茄子型フラスコに仕込み、これに塩化白金酸(30m g)を加え、70℃に加熱して溶解させた。次いで、こ れにヒドロシリルジクロライド(1.7g、23mol)を (パーフルオロブタジエニルナフチル基含有アルケニル 30 徐々に加え、そのまま、70℃で3時間、反応させて、 目的とするパーフルオロブタジエニルナフチルオキシプ ロピルジクロロシラン体の粗生成物(8.2g)を得た。 【0143】C)パーフルオロブタジエニルナフタレン 型トリシロキサンの合成

> トリエチルアミン (3.4 m L、25 mol) のトルエン (40mL)溶液に上記パーフルオロブタジエニルナフ チルオキシプロピルジクロロシラン体(8.2g、16.4 nmol)のトルエン(40mL)溶液とジシロキサンジオ ール (2.1 g、1 2 mmol) のメチルエチルケトン (40 mL)溶液とを室温下に同じ滴下速度にて徐々に加え、 3時間室温で攪拌した後に、白色の不溶物(トリエチル アミン塩酸塩)を沪去した。 得られた反応溶液にエー テル(300mL)を加え、エーテル層を水洗し、この エーテル層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させた後、エ ーテルをエバポレータにて除去し、得られた濃縮残渣 (9.3g)をシリカクロマトグラフイー(展開溶媒クロ ロホルム/ヘキサン(1/1)で精製して、目的とする パーフルオロブタジエニルナフタレン型トリシロキサン を得た(2.8g、純度99%、2段階収率29%)。

型トリシロキサン体のプロトンNMRスペクトルを図2 6に、赤外線吸収スペクトルを図27に、フッ素NMR スペクトルを図28に、また、その拡大スペクトルを図 29に示す。

【0145】D) パーフルオロブタジエニル基含有アル ケニル型ポリシロキサンの合成(ポリマー化)

上記パーフルオロブタジエニルナフタレン型トリシロキ サン(1.36g、2.27mmol) にジビニルジシロキサン (15.2 mg、0.082 mmol)を加え、これに硫酸(7*

元素分析值:

実測値 C: 45.20%、H: 4.55%、F: 26.55% 計算値 C: 45.48%、H: 4.35%、F: 26.65%

【0146】E) Si-H基を有するパーフルオロブタ ジエニル基含有オルガノヒドロポリシロキサンの合成 (ポリマー化)

前記パーフルオロブタジエニルナフタレン型トリシロキ サン (0.60g、1.00miol) にヘキサメチルジシロキ サン(28.8 mg、0.214 mol)とテトラメチルテト ラシロキサン (52.8g、0.220mmol) を加え、これ に硫酸(7mg)を室温で滴下し、終夜、攪拌した。こ 20 る。 の後、得られた反応混合物にトルエン(10mL)を加※

※え、トリエチルアミンにて反応系を中和し、生成した白 色の不溶物 (トリエチルアミン硫酸塩) を沪去した。溶 媒と未反応物をストリッピング(1mmHg、80℃) で除去して、目的とするSi-H基を有するパーフルオ ロブタジエニル基含有含フッ素オルガノヒドロポリシロ キサン(以下、水素オイルという。)を得た。計算分子 量Mw=3160、官能基(Si-H)数=6.1であ

34

*mg)を室温下に滴下し、終夜、攪拌した。この後、反

応混合物にトルエン(10mL)を加え、トリエチルア

ミンにて反応系を中和し、生成した白色の不溶物(トリ

エチルアミン硫酸塩)を沪去した。溶媒と未反応物をス

トリッピング(1mmHg、80℃)で除去して、分子

の両末端にビニル基を有するパーフルオロブタジエニル

(以下、ビニルオイルという。)を得た。計算分子量M

基含有含フッ素アルケニル型オルガノポリシロキサン

w=16700、官能基数Vi=2である。

元素分析值:

実測値 C: 38.58%、H:5.22%、F: 26.45% 計算值 C:38.74%、H:5.09%、F:26.68%

【 0 1 4 7 】実施例1

参考例9において得た分子の両末端にビニル基を有する アルケニル型オルガノポリシロキサンと、分子中にSi -H基を有するオルガノヒドロポリシロキサンとを合計 量が100重量部となり、且つ、Si-H基/ビニル基 ス(トリフルオロメチル)ベンゼン900重量部に溶解 し、更に、この溶液に塩化白金酸1mgをエタノール/ トルエン (1mL/3mL) 混合溶剤に溶解させた触媒 溶液6重量部を加えた。

【0148】次いで、上記溶液に参考例2において得た パーフルオロブタジエニルベンゼン100重量部を配合 して、コーティング溶液を調製した。このコーティング 溶液をアプリケータ法(25μm)にてガラス板に塗布 し、風乾して、シリコーン被膜を得た。このようにして 得たシリコーン被膜に、上方から低圧水銀灯又は高圧水 40 エネルギーを求めた。結果を表2に示す。 銀灯にて紫外線を照射して、化学変化を生じさた後、こ の被膜を更に150℃で10分間、加熱して、架橋被膜 とした。このようにして得られた架橋被膜を10%濃度 のトリエチルアミンを含むN-メチル-2-ピロリドン 溶液に浸漬し、架橋被膜をこの溶液に溶解させるに足る 最小の紫外線照射エネルギーを求めた。結果を表2に示

【0149】実施例2~5

参考例9において得た分子の両末端にビニル基を有する アルケニル型オルガノポリシロキサンと、分子中にSi★50 媒溶液6重量部を加えた。

★一H基を有するオルガノヒドロポリシロキサンとを合計 量が100重量部となり、且つ、Si-H基/ビニル基 の官能基比率が2.0となるように配合し、これをm-ビ ス(トリフルオロメチル)ベンゼン900重量部に溶解 し、更に、この溶液に塩化白金酸10mgをエタノール の官能基比率が2.0となるように配合し、これをm-ビ 30 /トルエン(1mL/3mL)混合溶剤に溶解させた触 媒溶液6重量部を加えた。

【0150】次いで、上記溶液に参考例5~8において 得たパーフルオロブタジエニル芳香族化合物を表2に示 すように20~100重量部配合して、コーティング溶 液を調製した。このコーティング溶液をアプリケータ法 (25µm)にてガラス板に塗布し、風乾して、シリコ ーン被膜を得、これに実施例1と同様にして紫外線を照 射した後、加熱架橋させ、この架橋被膜を実施例1と同 様にして前記溶液に溶解させるに足る最小の紫外線照射

【0151】比較例1

参考例9において得た分子の両末端にビニル基を有する アルケニル型オルガノポリシロキサンと、分子中にSi -H基を有するオルガノヒドロポリシロキサンとを合計 量が100重量部となり、且つ、Si-H基/ビニル基 の官能基比率が2.0となるように配合し、これをmービ ス(トリフルオロメチル)ベンゼン900重量部に溶解 し、更に、この溶液に塩化白金酸10mgをエタノール /トルエン(1mL/3mL)混合溶剤に溶解させた触

【0152】このコーティング溶液をアプリケータ法(25μm)にてガラス板に塗布し、風乾して、シリコーン被膜を得、これに実施例1と同様にして紫外線を照射した後、加熱架橋させ、この架橋被膜を実施例1と同*

*様にして前記溶液に溶解させるに足る最小の紫外線照射 エネルギーを求めた。結果を表2に示す。

[0153]

【表2】

	パーフルオロブタジエニル	最小エネルギー量(m J/cm²)	
	芳香族化合物の配合量	高圧水銀灯を用	低圧水銀灯を用
	(重量部)	いた場合	いた場合
実施例1	100	850	650
実施例2	100	680	520
実施例3	100	990	740
実施例4	50	640	360
	100	560	340
	200	540	330
実施例 5	100	620	380
	200	600	360
比較例1	0	>10000	4500

【0154】実施例6

参考例10において得た分子の両末端にビニル基を有するパーフルオロブタジエニル基含有アルケニル型オルガノポリシロキサンと、分子中にSi-H基を有するパーフルオロブタジエニル基含有オルガノヒドロボリシロキサンとを合計量が100重量部となり、且つ、Si-H基/ビニル基の官能基比率が2.0となるように配合し、これをm-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン900重量部に溶解し、更に、この溶液に塩化白金酸10mgをエタノール/トルエン(1mL/3mL)混合溶剤に溶解させた触媒溶液6重量部を加えた。

【0155】次いで、上記溶液に参考例2において得たパーフルオロブタジエニルベンゼン100重量部を配合して、コーティング溶液を調製した。このコーティング溶液をアプリケータ法(25μm)にてガラス板に塗布し、風乾して、シリコーン被膜を得た。このようにして得たシリコーン被膜に、上方から低圧水銀灯又は高圧水銀灯にて紫外線を照射した後、この被膜を更に150℃で10分間加熱して、架橋被膜とした。このようにして得られた架橋被膜を10%濃度のトリエチルアミンを含むNーメチルー2ーピロリドン溶液に浸漬し、架橋被膜40をこの溶液に溶解させるに足る最小の紫外線照射エネルギーを求めた。結果を表3に示す。

20%【0156】実施例7~10

参考例10において得た分子の両末端にビニル基を有するパーフルオロブタジエニル基含有アルケニル型オルガノポリシロキサンと、分子中にSi-H基を有するパーフルオロブタジエニル基含有オルガノヒドロポリシロキサンとを合計量が100重量部となり、且つ、Si-H基/ビニル基の官能基比率が2.0となるように配合し、これをm-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン900重量部に溶解し、更に、この溶液に塩化白金酸10mgをエタノール/トルエン(1mL/3mL)混合溶剤に30溶解させた触媒溶液6重量部を加えた。

【0157】次いで、上記溶液に参考例5~8において得たパーフルオロブタジエニル芳香族化合物を表3に示すように20~100重量部配合して、コーティング溶液を調製した。このコーティング溶液をアプリケータ法(25μm)にてガラス板に塗布し、風乾して、シリコーン被膜を得、これに実施例1と同様にして紫外線を照射した後、加熱架橋させ、この架橋被膜を実施例1と同様にして前記溶液に溶解させるに足る最小の紫外線照射エネルギーを求めた。結果を表3に示す。

40 [0158]

【表3】

	パーフルオロブタジエニル	最小エネルギー量(m J / cm²)	
	芳香族化合物の配合量	高圧水銀灯を用	低圧水銀灯を用
	(重量部)	いた場合	いた場合
実施例6	100	570	340
実施例7	100	560	330
実施例 8	100	590	340
実施例9	50	520	320
	100	510	310
	200	500	300
実施例10	100	560	330
	200	540	320

【0159】実施例11~15

参考例11において得た分子の両末端にビニル基を有するパーフルオロブタジエニル基含有含アルケニル型オルガノポリシロキサンと、分子中にSi-H基を有するパーフルオロブタジエニル基含有オルガノヒドロポリシロキサンとを合計量が100重量部となり、且つ、Si-H基/ビニル基の官能基比率が2.0となるように配合し、これをmービス(トリフルオロメチル)ベンゼン900重量部に溶解し、更に、この溶液に塩化白金酸10mgをエタノール/トルエン(1mL/3mL)混合溶剤に溶解させた触媒溶液6重量部を加えた。

【0160】次いで、上記溶液に参考例2、5~8において得たパーフルオロブタジエニル芳香族化合物を50~200重量部の範囲で配合して、コーティング溶液を*

*調製した。このコーティング溶液をアプリケータ法(25μm)にてガラス板に塗布し、風乾して、シリコーン被膜を得た。

【0161】このようにして得たシリコーン被膜に、上方から低圧水銀灯又は高圧水銀灯にて紫外線を照射した後、この被膜を更に150℃で10分間加熱して、架橋被膜とした。このようにして得られた架橋被膜を10%濃度のトリエチルアミンを含むNーメチルー2ーピロリドン溶液に浸漬し、架橋被膜をこの溶液に溶解させるに足る最小の紫外線照射エネルギーを求めた。結果を表4に示す。

【0162】 【表4】

	パーフルオロブタジエニル	最小エネルギー量(m J/cm²)	
	芳香族化合物の配合量	高圧水銀灯を用	低圧水銀灯を用
'	(重量部)	いた場合	いた場合
実施例11	100	600	350
実施例12	100	580	360
実施例13	100	620	340
実施例14	50	540	340
	100	530	330
	200	520	320
実施例15	100	570	340
	200	560	330

【図面の簡単な説明】

【図1】は4-パーフルオロブタジエニルフェニルアリルエーテルのプロトンNMRスペクトルである。

【図2】は4ーパーフルオロブタジエニルフェニルアリルエーテルの赤外線吸収スペクトルである。

【図3】は4ーパーフルオロブタジエニルフェニルアリルエーテルのフッ素NMRスペクトルである。

【図4】は5ーパーフルオロブタジエニルナフチルアリルエーテルのプロトンNMRスペクトルである。

【図5】は5ーパーフルオロブタジエニルナフチルアリ※50 フェニルの赤外線吸収スペクトルである。

※ルエーテルの赤外線吸収スペクトルである。

【図6】は5ーパーフルオロブタジエニルナフチルアリルエーテルのガスクロマトグラフィー質量分析スペクトルである。

【図7】は5-パーフルオロブタジエニルナフチルアリルエーテルのフッ素NMRスペクトルである。

【図8】は4,4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ビフェニルのプロトンNMRスペクトルである。

【図9】は4,4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ビフェニルの赤外線吸収スペクトルである。

【図10】は4.4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ビフェニルのガスクロマトグラフィー質量分析スペクト ルである。

【図11】は4,4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ビフェニルのフッ素NMRスペクトルである。

【図12】は4.4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ジフェニルエーテルのプロトンNMRスペクトルである。

【図13】は4,4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ジフェニルエーテルの赤外線吸収スペクトルである。

【図14】は4,4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ジフェニルエーテルのガスクロマトグラフイー質量分析 スペクトルである。

【図15】は4,4'ービス (パーフルオロブタジエニル) ジフェニルエーテルのフッ素NMRスペクトルである。

【図16】はパーフルオロブタジエニルベンゼン型トリシロキサン体のプロトンNMRスペクトルである。

【図17】はパーフルオロブタジエニルベンゼン型トリシロキサン体の赤外線吸収スペクトルである。

【図18】はパーフルオロブタジエニルベンゼン型トリ 20 シロキサン体のフッ素NMRスペクトルである。

【図19】はパーフルオロブタジエニルベンゼン型トリ

シロキサン体のフッ素NMRスペクトルの拡大である。 【図20】はビニルオイルのプロトンNMRスペクトル である。

4.0

【図21】はビニルオイルの赤外線吸収スペクトルである

【図22】はビニルオイルのフッ素NMRスペクトルである

【図23】は水素オイルのプロトンNMRスペクトルである。

10 【図24】は水素オイルの赤外線吸収スペクトルである。

【図25】は水素オイルのフッ素NMRスペクトルである。

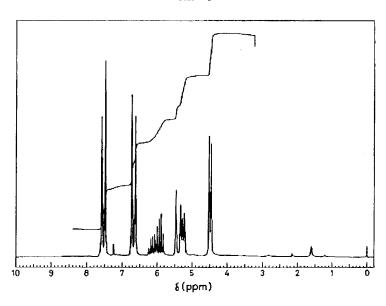
【図26】はパーフルオロブタジエニルナフタレン型トリシロキサン体のプロトンNMRスペクトルである。

【図27】はパーフルオロブタジエニルナフタレン型トリシロキサン体の赤外線吸収スペクトルである。

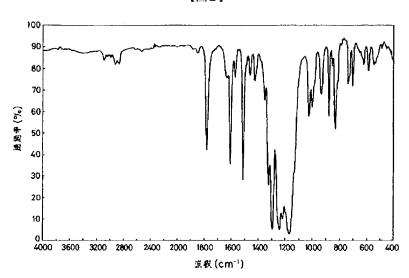
【図28】はパーフルオロブタジエニルナフタレン型トリシロキサン体のフッ素NMRスペクトルである。

【図29】はパーフルオロブタジエニルナフタレン型トリシロキサン体のフッ素NMRスペクトルの拡大である。

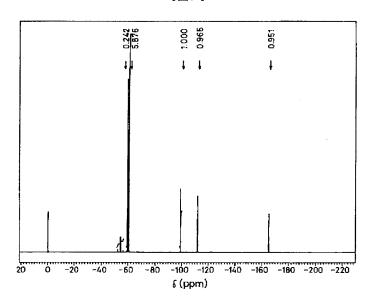
【図1】



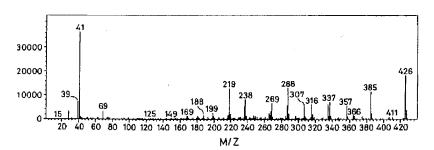




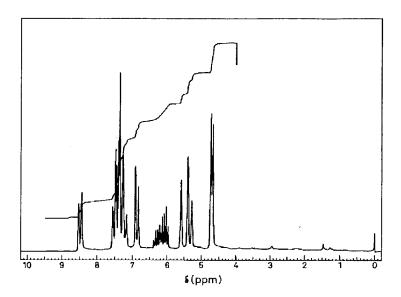
【図3】



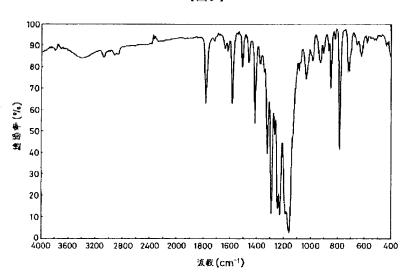
【図6】



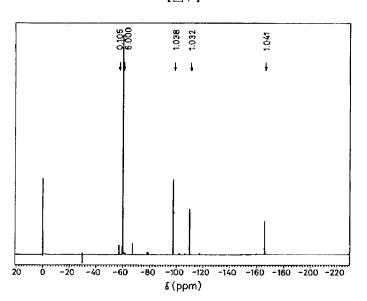
【図4】



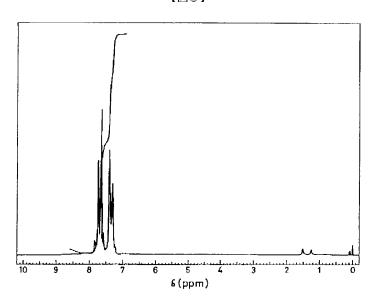


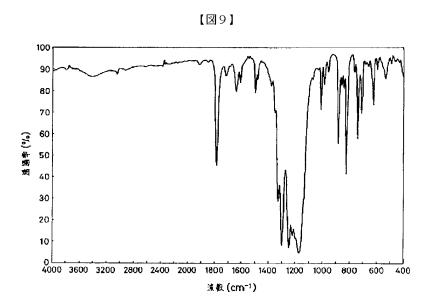


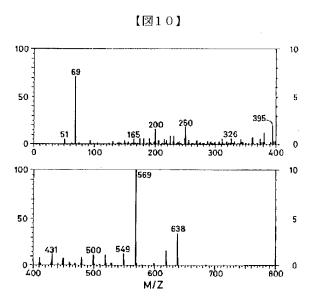
【図7】



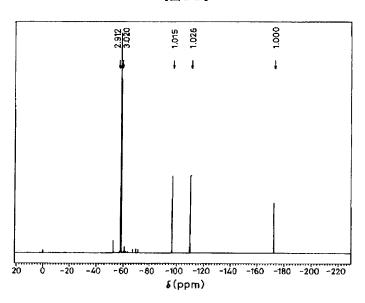
[図8]



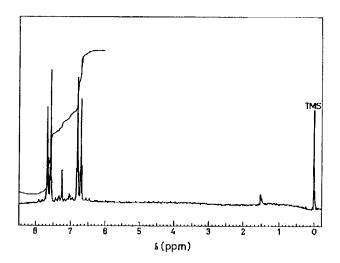




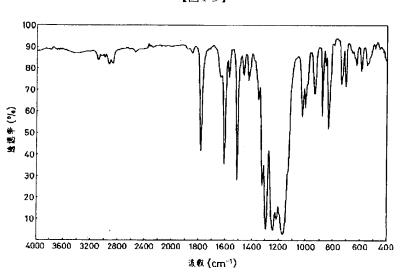
【図11】



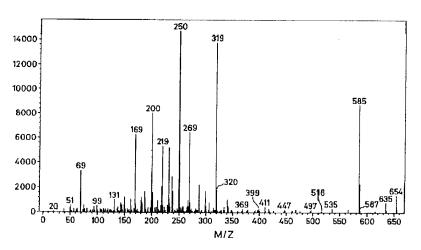
【図12】



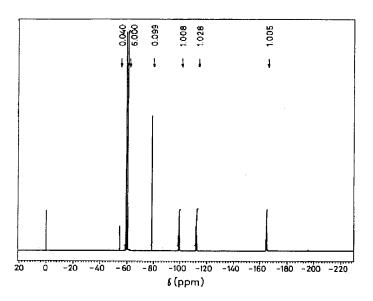




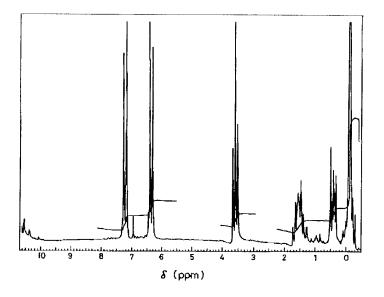
【図14】

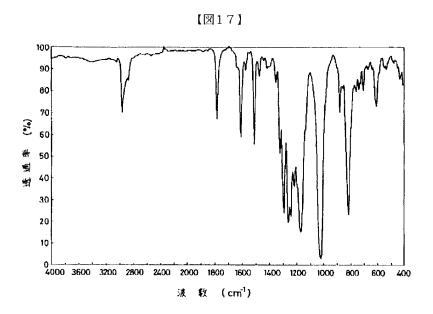


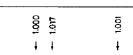
【図15】



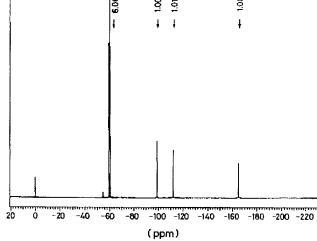
【図16】



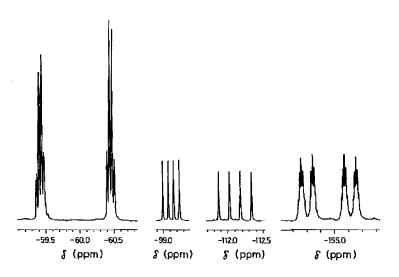




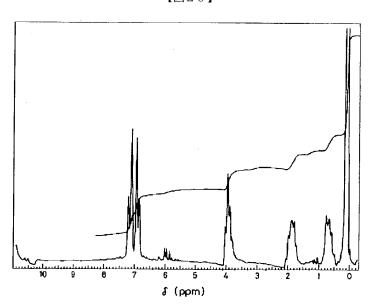
【図18】



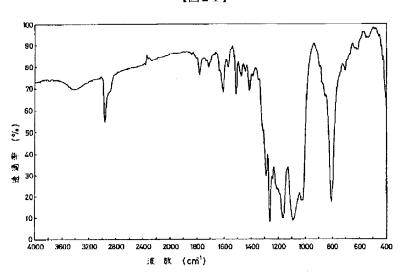
【図19】



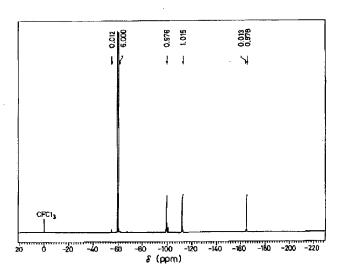
【図20】



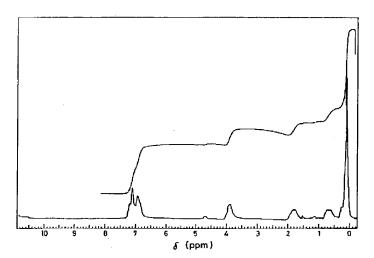
【図21】



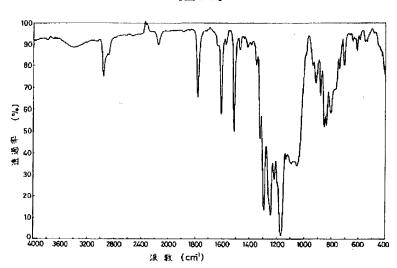
【図22】



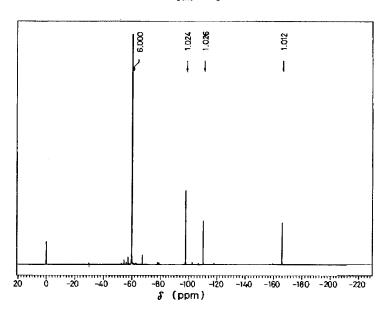
【図23】



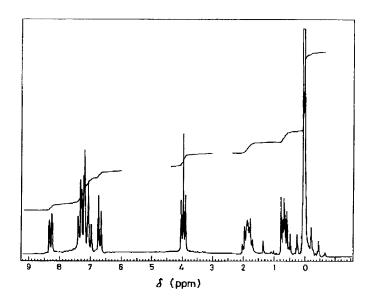




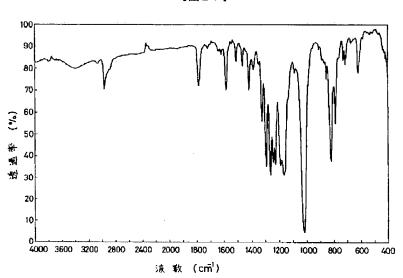
【図25】



【図26】







【図28】

